(19) 日本国特許厅(JP)

(12)公 表 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公表番号

特表2005-508437 (P2005-508437A)

最終頁に続く

(43) 公表日 平成17年3月31日(2005.3.31)

(51) Int.C1. ⁷ CO9K 11/06 CO7D 215/10 CO7D 217/10 CO7D 217/16 CO7D 401/04		215/10 217/10 217/16	660	テーマコー 3K007 4C034 4C063 4H050 (全 60 頁)	
(21) 出願番号 (86) (22) 出顧日 (85) 翻訳文提出日 (86) 国際出願番号 (87) 国際公開日 (31) 優先權主張番号 (32) 優先日 (33) 優先權主張国	特顏2003-542296 (P2003-542296) 平成14年11月4日 (2002.11.4) 平成16年5月7日 (2004.5.7) PCT/US2002/035429 ₩02003/040256 平成15年5月15日 (2003.5.15) 60/347,911 平成13年11月7日 (2001.11.7) 米国 (US)	(74) 代理/	イー・アイ・ラ アンド・カン/ E. I. DU URS ANI アメリカ合衆目 ントン、マーク 7 人 100077481 弁理士 谷 都	ペニー PONT D COMPA は、デラウエア アット・ストリ	PE NEMO NY 別、ウイルミ

(54) 【発明の名称】 赤橙色または赤色発光を有するエレクトロルミネセンスイリジウム化合物及びかかる化合物で製造されたデバイス

(57)【要約】

本発明は概して、可視スペクトルの赤橙色から赤色領域の発光最大を有するエレクトロルミネセンス I r (I I I) 錯体、及び前記 I r (I I I) 錯体で製造されるデバイスに関する。

$$(R^{1})_{\alpha} \qquad \qquad (R^{1})_{\alpha} \qquad \qquad (R^{1})_{\beta} \qquad \qquad (R^{1})_{\beta}$$

【特許請求の範囲】

【請求項1】

式 I 及び式 I I :

Ir La

(I)

IrL, Z

(II)

から選択される式を有する少なくとも1つの化合物を含む活性層であって、 式中、

Ζが、β-ジェノレート、アミノカルボキシレート、イミノカルボキシレート、サリチレ ート、ヒドロキシキノレート、及びジアリールホスフィノアルコキシドから選択され、 Lが、図1の式III、式IV、式V、式VI、及び式VII、ならびに図2の式VII I、式IX及び式Xから選択され、

式IIIにおいて、

 $R^3 \sim R^6$ が同一または異なっており、 $R^3 \sim R^6$ の少なくとも1つが、D、F、C $_n$ F 2n+1、OCn F_{2n+1}、及びOCF₂ Yから選択され、

式III~VIIのいずれかにおいて、出現するごとに、

 R^{-1} が、出現するごとに、同一または異なっており、D、 C_{n} H_{2n+1} 、 OR^{1-1} 、S $\mathbb{R}^{\ 1\ 1}$, \mathbb{N} ($\mathbb{R}^{\ 1\ 1}$) $_2$, \mathbb{F} , $\mathbb{C}_{\ n}$ ($\mathbb{H}+\mathbb{F}$) $_{2\ n\ +\ 1}$, \mathbb{O} $\mathbb{C}_{\ n}$ ($\mathbb{H}+\mathbb{F}$) $_{2\ n\ +\ 1}$, \mathbb{X} びOCF₂ Yから選択されるか、または隣接する一対のR¹ が結合して5または6員環を 形成することができ、

YがH、Cl、またはBrであり、

AがSまたはNR¹¹であり、

式III~Xのいずれかにおいて、出現するごとに、

 R^{-1-1} が、出現するごとに、同一または異なっており、H または C_n H_{2-n+1} であり、 nが1~12の整数であり、

 α \vec{n} $\vec{0}$ $\vec{0}$ $\vec{1}$ $\vec{1$

式IV~Xのいずれかにおいて、出現するごとに、

δが0または1~4の整数であり、

式VIIにおいて、

 $E^{-1}\sim E^{-4}$ が同一または異なっており、Nまたは $CR^{-1/2}$ であるが、ただし、少なくとも 1つのEがNであり、

 R^{1} が、出現するごとに、同一または異なっており、H、D、S R^{1} 1 、N $(R^{1}$ 1) 2 、 F 、 C n (H + F) 2 n + 1 、 O C n (H + F) 2 n + 1 、 及び O C F 2 Y から選択 され、または隣接した一対のR¹²が結合して5または6員環を形成するが、ただし、R $^{1-2}$ の少なくとも1つが、D、F、C $_{n}$ (H+F) $_{2\ n+1}$ 、OС $_{n}$ (H+F) $_{2\ n+1}$ 、及びOCF2Yから選択され、

式VIII~Xのいずれかにおいて、出現するごとに、

 $R^{\ 2}$ 及び $R^{\ 7}\sim R^{\ 1}$ 。 が、出現するごとに、同一または異なっており、H、D、 C_n H_2 n + 1 、O R ^{1 1} 、S R ^{1 1} 、及びN (R ^{1 1}) ₂ から選択され、または隣接した一対の R基が結合して5または6員環を形成することができるが、

ただし、活性層が、前記少なくとも1つの化合物、20重量%未満を含有する場合、希釈 剤が存在していることを特徴とする活性層。

【請求項2】

570~700nmの範囲の発光最大を有する発光材料を含むことを特徴とする、請求項 1に記載の活性層を含む有機電子デバイス。

【請求項3】

R⁵ がCF₃ であり、及び/またはR⁸ がOCH₃ 及びOHから選択され、及び/または R⁹がt-ブチルであることを特徴とする、請求項1に記載の活性層、または請求項2に 記載のデバイス。

【請求項4】

 $N, N' - \Im J_{x} = N - N, N' - \Im J_{x} = (3 - 2 + N) - [1, 1' - \Im J_{x} = 1)$

20

ル] -4, 4' -ジアミン、1, 1-ビス[(ジ-4-トリルアミノ) フェニル] シクロ ヘキサン、N, N'ービス (4ーメチルフェニル) -N, N'ービス (4ーエチルフェニ ル) - [1, 1'-(3, 3'-ジメチル) ピフェニル] -4, 4'-ジアミン、テトラ キスー (3-メチルフェニル) - N , N , N , N , - 2 , 5-フェニレンジアミン、 α ーフェニルー4-N, Nージフェニルアミノスチレン、p - (ジエチルアミノ) ベンズア ルデヒドジフェニルヒドラゾン、トリフェニルアミン、ビス [4-(N, N-ジェチルア ミノ) -2-メチルフェニル] (4-メチルフェニル) メタン、1-フェニル-3-[p - (ジエチルアミノ)スチリル]-5- [p- (ジエチルアミノ) フェニル] ピラゾリン 、1,2-トランスーピス(9H-カルバゾル-9-イル)シクロブタン、N,N,N' , N'ーテトラキス(4ーメチルフェニル)-(1 , 1'ービフェニル)-4 , 4'-ジ アミン、ポルフィリン化合物、及びそれらの組合せから選択される正孔輸送層を更に含む ことを特徴とする、請求項2または3に記載のデバイス。

【請求項5】

トリス (8-ヒドロキシキノラト) アルミニウム、2, 9-ジメチルー4, 7-ジフェニ ルー1, 10-フェナントロリン、4, 7-ジフェニル-1, 10-フェナントロリン、 2-(4-ビフェニリル) -5-(4-t-プチルフェニル) -1, 3, 4-オキサジアゾール、3- (4-ビフェニリル) -4-フェニル-5- (4-t-ブチルフェニル) -1, 2, 4-トリアゾール、及びそれらの組合せから選択される電子輸送層を更に含むこ とを特徴とする、請求項2~4のいずれか一項に記載のデバイス。

【請求項6】

表1に示した錯体1-a~1-mから選択される化合物。

【請求項7】

式 I 及び式 I I から選択される式を有する前記少なくとも 1 つの化合物が、表 1 に示した 錯体1-a~1-mから選択されることを特徴とする、請求項1または3に記載の活性層 、あるいは請求項2~5のいずれか一項に記載のデバイス。

【請求項8】

前記希釈剤が、ポリ(N-ビニルカルバゾール)、ポリシラン、4,4'-N,N'-ジ カルバゾールビフェニル、及び第三級芳香族アミンから選択されることを特徴とする、請 求項1、3及び7のいずれか一項に記載の活性層、あるいは請求項2~5、及び7のいず れか一項に記載のデバイス。

【請求項9】

前記希釈剤が、ポリアリーレンビニレン、ポリフルオレン、ポリオキサジアゾール、ポリ アニリン、ポリチオフェン、ポリピリジン、ポリフェニレン、それらのコポリマー、及び それらの組合せから選択される共役ポリマーであることを特徴とする、請求項1、3及び 7~8のいずれか一項に記載の活性層、あるいは請求項2~5、及び7~8のいずれか一 項に記載の有機電子デバイス。

【請求項10】

前記希釈剤が、ポリアリーレンビニレン、ポリフルオレン、ポリオキサジアゾール、ポリ アニリン、ポリチオフェン、ポリピリジン、ポリフェニレン、それらのコポリマー、及び それらの組合せから選択される共役ポリマーであることを特徴とする、請求項1、3及び 7~9のいずれか一項に記載の活性層、あるいは請求項2~5及び7~9のいずれか一項 に記載の有機電子デバイス。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

この発明は、可視スペクトルの赤橙色及び赤色領域の発光スペクトルを有するイリジウム (III) のエレクトロルミネセンス錯体に関する。それはまた、活性層がエレクトロル ミネセンスIr(III)錯体を含有する電子デバイスに関する。

【背景技術】

[0002]

20

30

10

ディスプレイを構成する発光ダイオードなど、発光する有機電子デバイスが、多くの異なった種類の電子機器内に存在している。全てのかかるデバイスにおいて、有機活性層が、2つの電気的接触層の間に挟まれる。光が電気的接触層を通過することができるように、電気的接触層の少なくとも1つが光透過性である。電気的接触層の両端に電気を印可した時に、有機活性層が光透過性電気的接触層を通して発光する。

[0003]

発光ダイオード中の活性成分として有機エレクトロルミネセンス化合物を使用することが周知である。アントラセン、チアジアソール誘導体、及びクマリン誘導体などの単純な有機分子がエレクトロルミネセンスを示すことが知られている。例えば、フレンド(Friend)らの米国特許公報(特許文献 1)、ヘーガー(Heeger)らの米国特許公報(特許文献 2)、及びナカノ(Nakano)らの(特許文献 3)に開示されているように、半導性共役ポリマーもまた、エレクトロルミネセンス成分として用いられている。8ーヒドロキシキノレートと三価金属イオン、特にアルミニウムとの錯体が、エレクトロルミネセンス成分として広く用いられており、例えば、タン(Tang)らの米国特許公報(特許文献 4)に記載されている。

[0004]

イリジウムの有機金属錯体をドープされたポリマーの活性層を有するエレクトロルミネセンスデバイスが、バロウズ(Burrows)及びトンプソン(Thompson)の(特許文献 5)及び(特許文献 6)に記載されている。これらの錯体の大部分が、緑または青緑色の領域にピークのある発光スペクトルを有する。

[0005]

【特許文献1】

米国特許第5,247,190号明細書

【特許文献2】

米国特許第5,408,109号明細書

【特許文献3】

欧州特許出願公開第443 861号明細書

【特許文献4】

米国特許第5,552,678号明細書

【特許文献5】

国際公開第00/70655号パンフレット

【特許文献6】

国際公開第01/41512号パンフレット

【非特許文献1】

O. ローセ (O. Lohse)、P. テベニン (P. Thevenin)、E. ウォールドボーゲルシンレット (E. Waldvogel Synlett)、1999年、45

【非特許文献2】

「可溶性導電性ポリマーから製造された軟質発光ダイオード (Flexible light-emitting diodes made from soluble con 4 ducting polymers)」、ネイチャー (Nature) Vol. 357、477-479ページ (1992年6月11日)

【非特許文献3】

「カークオスマー化学技術百科辞典 (Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology)」、第4版、Vol. 18、837-860ページ、1996年、Y. ワング (Y. Wang) 著

【非特許文献4】

ヤマモト(Yamamoto)著、「ポリマー科学の進歩(Progress in Polymer Science)」、Vol. 17、1153ページ(1992) 【発明の開示】

20

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

可視スペクトルの赤色領域(625-700nm)で発光する効率的なエレクトロルミネ センス化合物が以前から必要とされている。

【課題を解決するための手段】

[0007]

本発明は、式Ⅰ及び式ⅠⅠ:

Ir La

(I)

IrL₂Z

(II)

から選択される式を有する金属錯体を目的とし、

式中、

Ζが、β-ジェノレート、アミノカルボキシレート、イミノカルボキシレート、サリチレ ート、ヒドロキシキノレート、及びジアリールホスフィノアルコキシドから選択され、 Lが、図1の式III、式IV、式V、式VI、及び式VII、ならびに図2の式VII I、式IX及び式Xから選択され、

式IIIにおいて、

 $R^3 \sim R^6$ が同一または異なっており、 $R^3 \sim R^6$ の少なくとも1つが、D、F、C $_n$ F 2 n + 1 、 O C n F 2 n + 1 、 及びO C F 2 Y から選択され、

式III~VIIのいずれかにおいて、出現するごとに、

 R^{-1} が、出現するごとに、同一または異なっており、D、 C_n H_{2-n+1} 、O R^{1-1} 、S $R^{1\ 1}$ 、 N ($R^{1\ 1}$) $_2$ 、 $_2$ 、 $_3$ 、 $_4$ C $_5$ ($_4$ + $_5$) $_2$ $_5$ + $_1$ 、 $_3$ O C $_5$ ($_4$ + $_5$) $_2$ $_5$ + $_1$ 、 $_3$ びOCF₂ Yから選択されるか、または隣接する一対のR¹ が結合して5または6員環を 形成することができ、

YがH、Cl、またはBrであり、

AがSまたはNR¹であり、

式III~Xのいずれかにおいて、出現するごとに、

 $R^{\ 1\ 1}$ が、出現するごとに、同一または異なっており、Hまたは $C_n\ H_{\ 2\ n\ +\ 1}$ であり、 nが1~12の整数であり、

 α が 0 、 1 または 2 であり、

式IV~Xのいずれかにおいて、出現するごとに、

δが0または1~4の整数であり、

式VIIにおいて、

 $E^{\ 1}\sim E^{\ 4}$ が同一または異なっており、Nまたは $C\,R^{\ 1}\,^{\ 2}$ であるが、ただし、少なくとも 1つのEがNであり、

 $R^{1 2}$ が、出現するごとに、同一または異なっており、H、D、S $R^{1 1}$ 、N $(R^{1 1})$ 2、 F、 C_n (H+F)_{2n+1}、 OC_n (H+F)_{2n+1}、 及びOCF₂ Yから選択 され、または隣接した一対のR¹²が結合して5または6員環を形成するが、ただし、R $^{1-2}$ の少なくとも1つが、D、F、C $_n$ (H+F) $_{2\ n\ +\ 1}$ 、OC $_n$ (H+F) $_{2\ n\ +\ 1}$ 、及びOCF2Yから選択され、

式VIII~Xのいずれかにおいて、出現するごとに、

 R^2 及び $R^7 \sim R^{10}$ が、出現するごとに、同一または異なっており、H、D、C $_n$ H $_2$ n+1、 OR^{1-1} 、 SR^{1-1} 、 Q UN (R^{1-1}) $_2$ から選択され、または隣接した一対の R基が結合して5または6員環を形成することができる。

[0008]

別の実施態様において、本発明は、570~700 nmの範囲の発光最大を有する発光層 を含む少なくとも1つの活性層を有する有機電子デバイスを目的とし、そこにおいて、活 性層の少なくとも20重量%が、上記の金属錯体、または上記の金属錯体の組合せを含む

[00009]

本明細書中で用いた用語「化合物(compound)」は、物理的な手段によって分離

10

30

40

40

50

できない原子からなる分子で構成された電気的に帯電していない物質を意味することを意 図する。用語「配位子(1igand)」は、金属イオンの配位圏に結合している分子、 イオン、または原子を意味することを意図する。アルファベット「L」は、水素イオンを 失うことによって中性親化合物「HL」から形成された公称(一1)電荷を有する配位子 を示すために用いられる。アルファベット「Z」は、水素イオンを失うことによって中性 親化合物「HZ」から形成された公称(-1)電荷を有する二座配位子を示すために用い られる。用語「錯体(complex)」は、名詞として用いられるとき、少なくとも1 つの金属イオン及び少なくとも1つの配位子を有する化合物を意味することを意図する。 用語「βージカルボニル (βーdicarbonyl)」は、2個のケトン基が、CHR 基によって隔てられて存在している中性化合物を意味することを意図する。用語「βーエ ノラート(βーenolate)」は、2個のカルボニル基の間のCHR基からHが引抜 かれたβージカルボニルのアニオンの形を意味することを意図する。用語「基(grου p)」は、有機化合物中の置換基または錯体中の配位子など、化合物の一部を意味するこ とを意図する。用語「面の(facial)」は、3個の「a」基がすべて隣接している 、すなわち、八面体の1つの面の角にある八面体の幾何学的形状を有する、錯体Maab 3 の 1 つの異性体を意味することを意図する。用語「メリジオナル(meridiona 1)」は、3個の「a」基が、2個が互いにトランス位であるように3位置を占める八面 体の幾何学的形状を有する、錯体Ma3b3の1つの異性体を意味することを意図する。 語句「に隣接する(adiacent to)」は、デバイス中の層を指すために用いる とき、1つの層が別の層のすぐ隣りにあることを必ずしも意味しない。他方、語句「隣接 するR基(adjacent R groups)」は、化学式中で隣り同士であるR基 (すなわち、結合によって連結した原子上にあるR基)を指すために用いられる。用語「 光活性(photoactive)」は、エレクトロルミネセンス及び/または感光性を 示すいずれかの材料を指す。更に、IUPAC命名法が全体にわたって用いられ、周期表 の族が、左から右に1から18の番号を付けられる(CRC Handbook of Chemistry and Physics、第81版、2000年)。化学式及び反 応式において、アルファベットA、E、L、R、Q、Y及びZは、そこに記載される原子 または基を示すために用いられる。他のすべてのアルファベットは、通常の原子記号を示 すために用いられる。用語「(H+F)」は、完全水素化、部分フッ素化、または過フッ 素化置換基を含めて、水素とフッ素のすべての組合せを意味することを意図する。「発光 最大 (emission maximum)」は、エレクトロルミネセンスの最大強度が 得られる、ナノメートル単位の波長を意味する。エレクトロルミネセンスは概してダイオ ード構造体において測定され、そこにおいて、試験される材料が2つの電気的接触層の間 に挟まれ、電圧が印加される。光の強さ及び波長はそれぞれ、例えば、フォトダイオード 及びスペクトログラフによって測定することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0010]

本発明の金属錯体は、上に記載した、式I及びIIを有し、環金属錯体(cyclome tallated complexes)と称される。式I及びIIのイリジウムが+3 の酸化数であり、六配位である。式Iにおいて、錯体は付加的な配位子がないトリス環金 属錯体である。トリス錯体は、面またはメリジオナル幾何学を示す場合があるが、非常に しばしば、面型異性体が形成される。式IIにおいて、錯体は、付加的なモノアニオンニ 座配位子2を有するビス環金属錯体である。これらの環金属イリジウム錯体は中性、非イ オン性であり、そのまま昇華することができる。真空蒸着によって得られたこれらの材料 の薄フィルムは、良~すぐれたエレクトロルミネセンスの性質を示す。

[0011]

本発明の錯体は、可視スペクトルの赤橙色~赤色領域である、570~700mmの範囲 で最大値を有する発光スペクトルを有する。好ましい赤色発光は620nm以上である。

[0012]

図1に示した、式IIIを有する配位子Lは、ピリジン環上に少なくとも1個のフッ素含

有置換基が存在する、チエニルーピリジン(AがSである場合)またはピロリルーピリジン(AがN R^{1-1} である場合)化合物から誘導される。 $R^3 \sim R^6$ 基が、アルキル、アルコキシ、ハロゲン、ニトロ、シアノ基、並びにジューテロ、フルオロ、フッ素化アルキル及びフッ素化アルコキシ基など、有機化合物の通常の置換基から選択されてもよい。上記の基は、部分フッ素化または完全フッ素化(過フッ素化)されてもよい。 α が0であり、 R^3 及び/または R^5 がフッ素含有置換基であるのが好ましい。 CF_3 が最も好ましい。A がN R^{1-1} であるとき、 R^{1-1} がC H_3 であるのが好ましい。

[0013]

図1に示した、式 I V を有する配位子 L が、チェニルまたはピロリルーキノリン化合物から誘導される。図1に示した、式 V または式 V I を有する配位子 L が、チェニルまたはピロリルーイソキノリン化合物から誘導される。 α が 0 であることが好ましい。 A が N R 1 であるとき、 R 1 が C H $_3$ であることが好ましい。

[0014]

[0015]

[0016]

親配位子化合物HLは概して、例えば、(非特許文献 1)に記載されているように、相応する複素環アリールクロリドの、有機ボロン酸または有機マグネシウム試薬との標準的な、パラジウム触媒によるスズキ(Suzuki)またはクマダ(Kumada)クロスカップリングによって調製されてもよい。この反応は、図4の反応式(1)において、フェニルーイソキノリンについて説明し、式中、R及びR、が置換基を示す。

[0017]

Z配位子がモノアニオン二座配位子である。概して、これらの配位子は配位原子としてN, O、P、またはSを有し、イリジウムに配位した時に5または6員環を形成する。適した配位基には、アミノ、イミノ、アミド、アルコキシド、カルボキシレート、ホスフィル、チオレートなどがある。これらの配位子の適した親化合物の例には、βージカルボニル(βーエノラート配位子)及びそれらのN及びS類似体、アミノカルボン酸(アミノカルボン酸(アミノカルボン酸(オシレート配位子)、ピリジンカルボン酸(イミノカルボキシレート配位子)、サリチル酸誘導体(サリチレート配位子)、ヒドロキシキノリン(ヒドロキシキノリネート配位子)及びそれらのS類似体、及びジアリールホスフィノアルカノール(ジアリールホスフィノアルコキシド配位子)などがある。

[0018]

 $\beta-x$ ノラート配位子は概して、図3に示した式X I を有し、式中、 R^{13} が、出現するごとに、同一または異なっている。 R^{13} 基が、水素、ハロゲン、置換または非置換アルキル、アリール、アルキルアリールまたは複素環基であってもよい。隣接する R^{13} 基が結合して5及び6員環を形成することができるが、それらは、置換されてもよい。好ましい R^{13} 基が、H、F、C $_n$ (H+F) $_2$ $_n+1$ 、-C $_6$ H $_5$ 、-C $_4$ H $_3$ S 、及び-C $_4$ H $_3$ O から選択され、式中、n が $1\sim 1$ 2 、好ましくは $1\sim 6$ の整数である。

[0019]

適したβ-エノラート配位子2の例には、以下に記載した化合物がある。β-エノラート の形態の路語を以下、括弧内に記載する。

[0020]

2, 4-ペンタンジオネート [acac]

1, 3-ジフェニルー1, 3-プロパンジオネート[DI]

2, 2, 6, 6ーテトラメチルー3, 5ーヘプタンジオネート [TMH]

4, 4, 4-トリフルオロ-1-(2-チエニル)-1, 3-ブタンジオネート[TTF A]

7, 7-ジメチル-1, 1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘプタフルオロー4, 6-オクタンジ オネート [FOD]

1, 1, 1, 3, 5, 5, 5-ヘプタフルオロー2, 4-ペンタンジオネート [F7ac a c]

1, 1, 1, 5, 5, 5-ヘキサフルオロー2, 4-ペンタンジオネート [F6acac

1-フェニルー3-メチルー4-i-ブチリルーピラゾリノネート [FMBP]

[0021]

β-ジカルボニル親化合物ΗΖが概して市販されている。F7acac、1,1,1,3 , 5, 5, 5-ヘプタフルオロー 2, 4-ペンタンジオン、CF₃ C (O) CFHC (O) CF₃の親化合物は、ペルフルオロペンテン-2とアンモニアとを反応させ、その後 に、加水分解工程を行うことによる2段法合成を用いて調製されてもよい。この化合物は 、加水分解しやすいので無水条件(anyhydrous conditions)下で 貯蔵及び反応させられるのがよい。

[0022]

ヒドロキシキノリン親化合物H2が、部分的または完全にフッ素化されてもよいアルキル またはアルコキシ基などの基で置換されてもよい。概して、これらの化合物は市販されて いる。適したヒドロキシキノリネート配位子2の例には、

8-ヒドロキシキノリネート[8hq]

2-メチル-8-ヒドロキシキノリネート [Me-8hq]

10-ヒドロキシベンゾキノリネート [10-hbq]

などがある。

親ヒドロキシキノリン化合物は概して市販されている。

ホスフィノアルコキシド親化合物HZは概して、図3に示した、式XIIを有し、式中、 R^{1-4} が、出現するごとに、同一または異なっていてもよく、 C_n (H+F) $_{2-n+1}$ 及 びC。(H+F)。から選択され、

 R^{1-5} が、出現するごとに、同一または異なっていてもよく、H及び C_n (H+F) $_{2-n}$ + 1 から選択され、

えが2または3である。

[0024]

適したホスフィノアルコキシド配位子の例を以下に記載した。これらの配位子の略語を以 下、括弧内に示す。

[0025]

3 - (ジフェニルホスフィノ) - 1 - オキシプロパン [dpp0]

1, 1-ビス (トリフルオロメチル) - 2- (ジフェニルホスフィノ) -エトキシド [t f m d p e O]

親ホスフィノアルカノール化合物は概して市販されている。

式Ⅰ及びⅠⅠは概して、先ず、架橋した塩化物ダイマーを形成することによって金属塩化 物塩から調製される。この反応は、図5に示した反応式 (2) のチエニルーピリジン配位 子について示される。次に、式Ⅰの錯体を形成するために、ダイマー1個当たりトリフル 10

20

オロ酢酸銀、AgOCOCF3、の2当量の存在下で、溶剤を用いずに、配位子親化合物 HLの過剰量を添加する。この反応を図5の反応式(3)に示す。式IIの錯体を形成す るために2配位子のナトリウム塩を、架橋した塩化物ダイマーに添加する。この反応を図 5の反応式(4)に示す。

[0027]

本発明の金属錯体の例を以下の表1に示す。出現するごとに、α及びδがゼロである。

【表 1 】

表 1

錯体	錯体の式	配位子の式	А	R 置換基	Z
1-a	ı	111	S	$R^6 = CF_3$	<u> </u>
1-b	ı	٧	S	無し	-
1-c	ı	ΙX	-	R ⁹ =t-ブチル	-
1-d	1	IX	*	$R^8 = OCH_3$	-
1-e	ı	IX	-	R ⁸ = OH	-
1-f	1	VIII	*	R ⁹ = t-ブチル	_
1-g	11	III	N-CH₃	R ⁵ = CF ₃	acac
1-h	11	V	S	無し	acac
1-i	11	IX	4	無し	acac
1-j]]	IX	***	R ^e = t-ブチル	acac
1-k	11	IX	•	R ⁸ = OCH ₃	acac
1-1	11	VIII	-	R ⁹ =t-ブチル	acac
1-m	II	IX	***	$R^7 = R^8 = R^9 = R^{10} = D$	acac

[0029]

表1の錯体は、化合物1-aの、約570nmから、化合物1-kの、約670nmまでエレクトロルミネセンス発光最大を有する。

[0030]

(電子デバイス)

本発明はまた、2つの電気的接触層の間に配置された少なくとも1つの光活性層を含む電子デバイスに関するものであり、そこにおいて、前記デバイスの少なくとも1つの光活性層が、本発明の錯体を含有する。図6に示すように、代表的なデバイス100が、アノード層110及びカソード層150、及びアノード110とカソード150との間の層120、130、及び140が一括して、層と称される。正孔注入/輸送層120がアノードに隣接している。電子輸送材料を含む任意の層140がカソードに隣接している。正孔注入/輸送層120とカソード(または任意の電子輸送層)との間に光活性層130がある。層120、130、及び140が個々に、及び一括して活性層と称される。

[0031]

デバイス100の適用に依存して、光活性層130は、印加電圧によって活性化される発 光層(発光ダイオードまたは発光電気化学電池など)、放射エネルギーに応答して印加バ イアス電圧を用いてまたは用いずに信号を生成する材料の層(光検出器など)であっても よい。光検出器の例には、光伝導セル、フォトレジスタ、フォトスイッチ、フォトトラン 10

20

30

ジスター、及び光電管、及び光電池などがあり、これらの用語は、マーカス、ジョン(M arkus、John)編、Electronics and Nucleonics Dictionary、470及び476 (マグローーヒル社 (McGraw-Hill , Inc.)、1966年)に記載されている。

[0032]

本発明の錯体は層130中の光活性材料として、または層140中の電子輸送材料として 特に有用である。層130中で用いられるとき、本発明の錯体は、有効であるために固体 質希釈剤(solid matrix diluent)中にある必要がないことがわか った。層の全重量に対して、20重量%より多い金属錯体、100重量%までの金属錯体 である層を、発光層として用いることができる。付加的な材料が、金属錯体を有する発光 層中に存在してもよい。例えば、螢光染料が、発光色を変えるために、存在していてもよ い。希釈剤もまた、添加してもよい。好ましくは、希釈剤は、層中の電荷輸送を容易にす る。希釈剤は、ポリ(Nービニルカルバゾール)及びポリシランなど、ポリマー材料であ ってもよい。それはまた、4,4'-N,N'-ジカルバソールビフェニルまたは第三級 芳香族アミンなどの小分子であってもよい。希釈剤が用いられるとき、金属錯体は概して 、少量で存在しており、層の全重量に対して、通常20重量%より少なく、好ましくは1 0重量%より少ない。

[0033]

本発明のイリジウム金属錯体と共に使用するのに有用である希釈剤の1つのタイプは、ポ リマーの三重項励起状態がイリジウム錯体の三重項励起状態より高いエネルギー準位にあ る共役ポリマーである。適した共役ポリマーの例には、ポリアリーレンビニレン、ポリフ ルオレン、ポリオキサジアゾール、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピリジン、ポリ フェニレン、それらのコポリマー、及びそれらの組合せなどがある。共役ポリマーは、例 えば、アクリル、メタクリル、またはビニル、モノマー単位の非共役部分を有するコポリ マーであってもよい。フルオレン及び置換フルオレンのホモポリマー及びコポリマーが特 に有用である。

[0034]

いくつか場合には、本発明の金属錯体は1つより多い異性の形で存在してもよく、または 異なった錯体の混合物が存在していてもよい。OLEDの上記の考察において、用語「金 属錯体」は、錯体及び/または異性体の混合物を包含することを意図することは、理解さ れよう。

[0035]

又、デバイスは概して、アノードまたはカソードに隣接していてもよい支持体(図示しな い)を備える。非常にしばしば、支持体はアノードに隣接している。支持体は軟質または 硬質であってもよく、有機または無機系であってもよい。概して、ガラスまたは軟質有機 フィルムが支持体として用いられる。アノード110は、正の電荷キャリアを注入または 集めるために特に効率的な電極である。アノードは好ましくは、金属、混合金属、合金、 金属酸化物または混合金属酸化物を含有する材料から製造される。適した金属には、11 族の金属、4、5、及び6族の金属、及び8-10族の遷移金属がある。アノードが光透 過性である場合、インジウムスズ酸化物など、12、13及び14族の金属の混合金属酸 化物が概して用いられる。アノード110はまた、(非特許文献2)に記載されているよう なポリアニリンなどの有機材料を含んでもよい。

[0036]

アノード層110は通常、物理蒸着またはスピンキャスト方法によって適用される。用語 「物理蒸着」は、真空中で行われる様々な蒸着方法を指す。従って、物理蒸着には、イオ ンビームスパッタリングなどのスパッタリングの全ての形、並びに電子ビーム蒸発及び抵 抗蒸発などの蒸着の全ての形を含める。有用な物理蒸着の特定の形は、 r f マグネトロン スパッタリングである。

[0037]

正孔輸送層120は概して、アノードに隣接している。層120の正孔輸送材料の例は、

20

例えば、(非特許文献3)に要約されている。正孔輸送分子及びポリマーの両方を用いるこ とができる。上に記載したTPD及びMPMPの他に、一般に用いられる正孔輸送分子は 、1, 1-ビス [(ジー4-トリルアミノ) フェニル] シクロヘキサン (TAPC) 、N , N'ービス(4ーメチルフェニル)-N, N'ービス(4ーエチルフェニル)- [1, 1'-(3, 3'-ジメチル) ビフェニル]-4, 4'-ジアミン (ETPD)、テトラ キスー (3-メチルフェニル) -N, N, N, N, -2, 5-フェニレンジアミン <math>(P)DA) 、a-7ェニルー4-N, N-ジフェニルアミノスチレン(TPS)、p-(ジエ チルアミノ) ベンズアルデヒドジフェニルヒドラゾン (DEH) 、トリフェニルアミン (TPA)、1-フェニルー3-[p-(ジエチルアミノ)スチリル]-5-[p-(ジェ チルアミノ) フェニル] ピラゾリン (PPRまたはDEASP) 、1, 2-トランスービ ス (9 H - カルバゾル - 9 - イル) シクロブタン (D C Z B) 、N, N, N', N' - テ トラキス (4-メチルフェニル) - (1, 1'-ビフェニル) - 4, 4'-ジアミン (T TB)、及び銅フタロシアニンなどのポルフィリン化合物である。一般に用いられる正孔 輸送ポリマーは、ポリビニルカルバゾール、(フェニルメチル)ポリシラン、ポリ(3, 4 - エチレンジオキシチオフェン)(PEDOT)、及びポリアニリンである。又、ポリ スチレン及びポリカーボネートなどのポリマー中に上に記載したような正孔輸送分子をド ープすることによって正孔輸送ポリマーを得ることが可能である。 [0038]

任意の層140が電子輸送を容易にするように機能できると共に、バッファ層または、層 の境界面の急冷反応を妨ぐ急冷防止層として役立つことができる。好ましくは、この層は 電子移動度を助長し、急冷反応を低減させる。任意の層140の電子輸送材料の例には、 トリス (8-ヒドロキシキノラト) アルミニウム (Alq3) などの金属キレートオキシ ノイド化合物、2, 9-ジメチル-4, 7-ジフェニル-1, 10-フェナントロリン (DDPA) または4, 7ージフェニルー1, 10ーフェナントロリン (DPA) などの、 フェナントロリンベースの化合物、及び2-(4-ビフェニリル)-5-(4-t-ブチ ルフェニル) -1, 3, 4-オキサジアゾール (PBD) 及び3- (4-ビフェニリル) -4-フェニル-5- (4-t-ブチルフェニル) -1, 2, 4-トリアゾール (TAZ)などのアソール化合物などがある。

[0039]

カソード150は、電子または負の電荷キャリアを注入または集めるのに特に効率的な電 極である。カソードは、第1の電気的接触層 (この場合、アノード) より低い自由エネル ギーを有するいずれの金属または非金属であってもよい。第2の電気的接触層の材料は、 1 族のアルカリ金属(例えば、Li、Cs)、2族(アルカリ土類)金属、12族の金属 、ランタニド、及びアクチニドから選択されてもよい。アルミニウム、インジウム、カル シウム、バリウム、サマリウム及びマグネシウムなどの材料、並びに組合せを用いること ができる。

[0040]

有機電子デバイス中に他の層を有することが周知である。例えば、層の正の電荷輸送及び /またはバンドギャップの整合を容易にするか、または保護層として機能するように、導 電性ポリマー層120と活性層130との間に層があってもよい(図示しない)。同様に 、負の電荷輸送及び/またはバンドギャップの整合を容易にするか、または保護層として 機能するように、活性層130とカソード層150との間に付加的な層があってもよい(図示しない)。本技術分野に周知である層を用いることができる。更に、上に記載された 層のいずれも、2つ以上の層から作製されてもよい。あるいは、無機アノード層110、 導電性ポリマー層120、活性層130、及びカソード層150のいくつかまたはすべて を表面処理して、電荷キャリア輸送効率を増大させることができる。成分層のそれぞれの 材料の選択は、高いデバイス効率を有するデバイスを提供する目標との兼ね合いを検討す ることによって決めるのが好ましい。

[0041]

各機能層が、1つより多い層で構成されてもよいことが理解される。

50

[0042]

単一層を適した基材上に順次に蒸着することによって前記デバイスを製造することができる。ガラス及びポリマーのフィルムなどの基材を用いることができる。熱的蒸発、化学できるができる。熱の蒸発を使用することができる。あるいは、有機層を、いずれかることができる。あるいは、有機層を、いずれかることができる。あるいは、有機層を、いずれかることができる。ができる。では、大田では、第一、1000人では、1000人のは、100

[0043]

金属錯体で製造された本発明のデバイスの効率を、デバイス中の他の層を最適にすることによって更に改良できることが理解される。例えば、Ca、Ba、Mg/Ag、またはLiF/Alなど、より効率的なカソードを用いることができる。動作電圧の低下または量子収量の増大をもたらす造形基材及び新規な正孔輸送材料もまた、適用可能である。又、付加的な層を加えて、様々な層のエネルギー準位を調整し、エレタトロルミネセンスを容易にすることができる。

[0044]

本発明のイリジウム錯体はしばしば燐光性及び光ルミネセンスであり、他の適用に有用である場合がある。例えば、イリジウムの有機金属錯体が、酸素感受性指示薬、バイオアッセイ中の燐光指示薬、及び触媒として用いられている。ビス環金属錯体を用いて、トリス環金属錯体を合成することができ、そこにおいて、第3の配位子が同一であるか、または異なっている。

【実施例】

[0045]

以下の実施例は、本発明の特定の特徴及び利点を示す。それらは、本発明の説明に役立てるものであり、制限することを意図するものではない。特に指示しない限り、すべてのパーセンテージはモルパーセントである。

[0046]

(実施例1)

この実施例は、配位子親化合物(H L)、2 - (2 - チエニル) - 5 - (トリフルオロメチル)ピリジンの調製について説明する。

[0047]

2 ーチエニルボロン酸(ランカスターシンセシス社(Lancaster Synthesis, Inc.)、1.00g、7.81mmmol)、2 ークロロー5ートリフルオロメチルピリジン(アルドリッチケミカルカンパニー(Aldrich Chemical Co.)、1.417g、7.81mmol)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0)(アルドリッチ、451mg、0.391mmol)、炭酸カリウム(EMサイエンス(EM Science)、3.24g、23.4mmol)、炭酸カリウムのmL)、及びジメトキシエタン(アルドリッチ、20mL)を、N2下で20時間、水性層を3×50mLのジエチルエーテルで抽出し、混合有機及び水性層を分離した。水性活動を3×50mLのジエチルエーテルで抽出し、混合有機分画を硫酸ナトリウムで乾燥で、濾液を乾燥状態まで蒸発させた。未精製の生成物を、溶離剤としてCH2Cl2/ヘキサン(1:1)を用いてシリカゲルフラッシュクロマトグラフィーによって精製し(生

10

20

30

20

40

成物 R f = 0.5)、白い結晶固体の生成物(収量= 5.2 g、73%の単離収量)を生 じた。 1 Н N M R (C D C 1 3 , 2 9 6 K , 3 0 0 M H z) : δ = 7 . 7 3 - 7 . 5 7 ($2\ H$, m) , 7 . 5 5 (1 H , d , J=8 . 5 H z) , 7 . 3 4 (1 H , d , J=4 . 8 Hz), 6.88 (1H, d, J=4.8Hz) ppm_o^{-1} F NMR (CDCl₃, 2 9 6 K, 2 8 2 M H z) $\delta = -$ 6 2 . 7 8 p p m $_{\circ}$

[0048]

(実施例2)

この実施例は、中間ジクロロ架橋ダイマー、 [IrCl{2- (2-チエニル)- 5- (トリフルオロメチル)ピリジン}2]2の調製について説明する。

[0049]

実施例1からの2- (2-チエニル) -5- (トリフルオロメチル) ピリジン (5 5 5 m g、2.42mmol)、三塩化イリジウム(ストレムケミカルズ(Strem Che ッチケミカルカンパニー、10mL)及び水(1mL)を15時間、窒素下で還流させ、 その後、反応物を室温に冷却させた。得られた沈殿生成物を濾過によって採取し、ヘキサ ンで洗浄し、真空中で乾燥させ、赤橙色の固体の生成物575mg (37%) を生じた。 1 H NMR (CDC1 $_{3}$, 296K, 300MHz) : $\delta = 9$. 30 (4H, d, J= 1.5 H z)、7.80 (4 H、d d、J = 2.0 H z 及び8.5 H z)、7.59 (4 H, d, J = 8.5 Hz), 7.21 (8H, d, J = 4.8 Hz), 5.81 (d, 4 H, J=4.9 Hz) $_{\circ}$ $^{1.9}$ F NMR (CDC1 $_{3}$, 296 K, 282 MHz) $\delta=-$ 62.07ppm.

[0050]

(実施例3)

この実施例は、トリス環金属イリジウム錯体、[Ir{2-(2-チエニル)-5-(ト リフルオロメチル)ピリジン}3]、表1の化合物1-aの調製について説明する。

実施例2の [IrCl {2-(2-チエニル) -5-(トリフルオロメチル) ピリジン} 2] 2 (100mg、0.073mmol)、実施例1の2-(2-チエニル)-5-(トリフルオロメチル) ピリジン(201mg、0.88mmol)、及びトリフルオロ酢 酸銀(アルドリッチ、40mg、0.18mmo1)を配合し、10分間、窒素下、17 0-180℃で撹拌した。次に、混合物を室温に冷却させ、それを最小量のジクロロメタ ン中に再溶解した。溶液を、溶離液としてジクロルメタン/ヘキサン(1:1)を用いて シリカゲルカラムを通過させた。カラム下に来る第1の赤橙色の分画(生成物Rf=0. 5)を集め、乾燥状態まで蒸発させた。残留物をヘキサン中で懸濁させ、沈殿した生成物 を濾過し、過剰なヘキサンで洗浄し、いずれの残留2-(2-チエニル)-5-(トリフ ルオロメチル) ピリジンをも除去し、赤橙色の固体の生成物を生じた。単離収量=50m g (39%) $_{\circ}$ 1 H NMR (CDC1 $_{3}$, 296K, 300MHz) : δ = 7.73 -7. 57 (6 H, m), 7. 55 (3 H, d, J = 8.5 Hz), 7. 34 (3 H, d, J = 4. 8 H z), 6. 8 8 (3 H, d, J = 4. 8 H z). $^{1 \ 9}$ F NMR (CDC1 $_3$, 2 9 6 K , 2 8 2 M H z) δ = - 6 2 . 7 8 $_{\mbox{\tiny a}}$

[0052]

表1の化合物1-b~1-fを、同様な手順を用いて調製した。

[0053]

(実施例4)

この実施例は、配位子親化合物、1-(4-t-ブチルフェニル)-イソキノリンの調製 について説明する。

[0054]

4-t-ブチルフェニルボロン酸(アルドリッチケミカルカンパニー、5.00g、30 . 5 6 m m m o 1) 、1 ークロロイソキノリン(アルドリッチケミカルカンパニー、5. 44g、30.56mmol)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0)(

[0055]

(実施例5)

この実施例は、ジクロロ架橋ダイマー、IrC1 {1-(4-t-Bu-フェニル) -イソキノリン} ₂] ₂ の調製について説明する。

[0056]

[0057]

(実施例6)

この実施例は、ビス環金属イリジウム錯体、 [Ir (acac) {1 - (4 - t - Bu - フェニル) - イソキノリン} 2]、表1の化合物 1 - jの調製について説明する。 【0058】

10

20

30

40

30

40

[0059]

表1の化合物1-g~1-i及び1-k~1-1を、同様な手順を用いて調製した。

[0060]

(実施例7)

この実施例は、配位子親化合物、1 - (ペルジューテロフェニル) - イソキノリンの調製について説明する。

[0061]

ペルジューテローベンゼンボロン酸、ジメチルエステル: -78 $\mathbb C$ の乾燥ジエチルエーテル (50 m L) に溶かしたブロモベンゼンー d 5 (アルドリッチケミカルカンパニー、10.0 g、61.7 m m o 1) の溶液に、窒素下、n-BuLi (アルドリッチ、ヘキサン中に1.6 M、38.6 m L) をゆっくりと2分かけて添加した。撹拌した混合物を2時間、室温に昇温させ、次いで、それを、 N_2 下、-78 $\mathbb C$ のトリメチルボレート (アルドリッチ、50 m L、494 m m o 1) 及び乾燥ジエチルエーテル (200 m L) の撹拌溶液を保有する別のフラスコに移した。得られた混合物を室温に昇温させ、15時間、撹性し、その後、氷冷2 MのHC1 (50 m L) を添加し、反応混合物を急冷した。有機相の生成物4.9 g (52%の収量)を生じた。 1 H NMR (CDC13, 296K, 30 MHz) δ 3.73 (br s) ppm。

[0062]

1- (ペルジューテロフェニル) -イソキノリン: 1-クロロイソキノリン (アルドリッ チケミカルカンパニー、5.00g、30.6mmol)、ペルジューテロベンゼンボロ ン酸、上記の合成からのジメチルエステル (4.87g、31.4mmol)、炭酸カリ ウム (EMサイエンス、8.4g、61.2mmol)、テトラキストリフェニルホスフ ィンパラジウム (0) (アルドリッチ、707mg、0.611mmol)、ジメトキシ メタン(アルドリッチ、100mL)及び水(100mL)を窒素下で配合し、混合物を 15時間、還流させた。この後に、有機層を分離し、水性層を3×50mLのジエチルエ ーテルで抽出した。混合有機成分を硫酸ナトリウムで乾燥させ、濾過し、乾燥状態まで蒸 発させた。得られた未精製生成物をシリカゲル・クロマトグラフィーによって精製した。 先ず、ホスフィン触媒を4:1のジクロロメタン/ヘキサンで溶出し、次いで、所望の生 成物を100%のジクロロメタンで、次いで、ジクロロメタン/メタノールで溶出した(95:5、生成物 R f = 0.6)。生成物分画を混合し、乾燥状態まで蒸発させ、白い固 体の所望の生成物 4.5 g (70%) を生じた。 ¹ H NMR (CDCl₃, 296K, $3\ 0\ 0\ M\ H\ z\)$: $\delta=8$. $6\ 0\ (1\ H$, d , J=5 . $7\ H\ z\)$, 8 . $1\ 0\ (1\ H$, d , J $= 8.5 \,\mathrm{Hz}$), 7.88 (1 H, d, J = 8.4 Hz), 7.67 (2 H, m), 7. 53 (1H, m) ppm.

[0063]

(実施例8)

この実施例は、ジクロロ架橋ダイマー、 [IrCl {1-(ペルジューテロフェニル)-イソキノリン}2]2の調製について説明する。

[0064]

実施例 701-(ペルジューテロフェニル)-イソキノリン(3.00g、<math>14.3mm o 1)、 $1rCl_3$ (H_2O)。(ストレムケミカルズ社) 2.42g、6.80mm o 1)、2-xトキシエタノール(アルドリッチケミカルカンパニー、45mL)、及び水(5mL)を窒素下で 15時間、還流しながら撹拌し、その後に、得られた沈殿生成物を濾過によって単離した。次に、それを過剰なメタノール、次いでジェチルエーテルで洗浄し、最後に真空中で乾燥させ、赤橙色の固体の所望の生成物を生じた。収量 =2.12g

[0065]

(実施例9)

この実施例は、ビス環金属イリジウム錯体、Ir(acac){1-(ペルジューテロフ

ェニル)-イソキノリン}₂、表1の化合物1-mの調製について説明する。

[0066]

実施例8の [IrCl {1-(ペルジューテロフェニル) -イソキノリン} 2] 2 (30 0 m g 、 0 . 2 3 2 m m o 1) 、アセチルアセトン、ナトリウム塩 (アルドリッチケミカ ルカンパニー、71mg、0.581mmol)、及び2-エトキシエタノール(アルド リッチ、15mL)を45分間、120℃で撹拌し、その後、揮発成分を真空中で除去し た。得られた残留物をジクロロメタン中で取り、溶離液としてジクロロメタンを有するシ リカゲルパッド中をに通した。第1の赤色の分画(Rf=1.0)を採取し、乾燥状態ま で蒸発させ、赤橙色の固体の所望の生成物を生じた。収量=230 (70%)。 ¹ H N MR (CDC1 $_3$, 296K, 300MHz) (= 8.99 (1H, m), 8.45 (1 H, d, J = 6.4 Hz), 7.98 (1 H, m), 7.75 (2H, m), 7.55 (¹ H, d, J=6.3 Hz)、5.29 (1 H, s)、1.79 (6 H, s) p p m。環 金属化反応(cyclometallation reaction)において生じる小 量のH/D交換による付加的な信号が観察された:8.24(0.5H, m)、6.96 (0.20 H, d, J=9.8 Hz)

[0067]

(実施例10)

この実施例は、本発明のイリジウム錯体を使用するOLEDの形成について説明する。

[0068]

正孔輸送層 (HT層)、エレクトロルミネセンスの層 (EL層) 及び少なくとも1つの電 子輸送層(ET層)を備える薄フィルムOLEDデバイスを熱的蒸発技術によって製造し た。油拡散ポンプを有するエドワードオート(Edward Auto)306蒸発器を 使用した。薄フィルム蒸着のすべての基礎真空は、10~6トールの範囲であった。蒸着 チャンバーは、真空を解除することを必要とせずに5つの異なったフィルムを蒸着するこ とができた。

[0069]

約1000-2000AのITO層を有するインジウムスズ酸化物(ITO)被覆ガラス 基材を使用した。最初に、基材をパターン化するために不要なITO領域を1N HC1 溶液でエッチングして除去し、第1の電極パターンを形成した。ポリイミドテープをマス クとして用いた。次に、パターン化ITO基材を洗剤水溶液中で超音波洗浄した。次いで 、基材を蒸留水で、その後でイソプロパノールですすぎ洗いし、次に約3時間、トルエン の蒸気中で脱脂した。あるいは、シンフィルムデバイス社(Thin Film Dev ices, Inc)製のパターン化ITOを用いた。これらのITOは、30オーム/平 方のシート抵抗及び80%の光透過性を有する、1400Å ITOコーティングで被覆 されたコーニング1737をベースとしている。

[0070]

次に、洗浄されたパターン化ITO基材を真空室中に入れ、真空室を10~6トールまで 下げた。次に、基材を約5-10分間、酸素プラズマを用いて更に清浄にした。洗浄した 後に、次いで、薄フィルムの多層を熱的蒸発によって基材上に順次に蒸着した。最後に、 Alのパターン化金属電極を、マスクによって蒸着した。フィルムの厚さを、水晶モニタ (サイコン (Sycon) STC-200) を用いて、蒸着する間に測定した。実施例 に記載したすべてのフィルム厚さは公称であり、蒸着された材料の密度が同一であると考 えて計算されている。次に、完成OLEDデバイスを真空室から取り出し、封入せずにす ぐに特性決定した。

[0071]

デバイス層及び厚さをまとめて表 2 に示す。全ての場合において、アノードは、上に記載 したようにITOであり、700-760Aの範囲の厚さを有するカソードはAIであっ た。

[0072]

【表 2】

表 2

試料	HT 層の	EL 層の	ET 層の	カソードの
	厚さ、Å	厚さ、Å	厚さ、Å	厚さ、Å
1	MPMP	化合物 1-A	DPA	Al
	504	411	418	737
2	MPMP	化合物 1-i	DPA	Al
	513	420	412	737
3	MPMP	化合物 1-j	DPA	Al
	513	414	400	721
4	MPMP	化合物 1-k	DPA	Al
	530	407	407	732
5	MPMP	化合物 1-l	DPA	Al
	533	411	414	727
6	MPMP	化合物 1-f	DPA	Al
	563	305	408	725
7	MPMP	化合物 1-h	DPA	Al
	538	409	418	734
8	MPMP	化合物 1-c	DPA	Al
	526	428	402	728
9	MPMP	化合物 1-m	DPA	Al
	530	404	415	725

10

DPA = 4,7ージフェニルー1,10ーフェナントロリン

= 電子輸送

ET EL

= エレクトロルミネセンス

НТ

= 正孔輸送

MPMP

= ビス[4ー(N,Nージエチルアミノ)ー2ーメチルフェニル](4ーメチルフェニル)メタン

[0073]

40

30

[0074]

結果を以下の表3に示す。

[0075]

【表3】

表 3 イリジウム化合物のエレクトロルミネセンス性質

試料	ピーク放射輝度、 Cd/m ²	ピーク効率、 Cd/A	近似ピーク波長、nm
1	25 V で 200 Cd/m²	1.5	570
2	22 V で 100 Cd/m²	0.65	620
3	22 V ਦ 200	1.2	625
4	21 V で 1	0.04	>670
5	22 V で 400	1.6	605 及び 640
6	20 V で 5	0.3	585
7	23 V で 7	0.06	620
8	23 V で 2.5	0.3	625
9	19 V ਾਰ 350	0.6	625

20

10

30

[0076]

(実施例11)

この実施例は、ポリ(フルオレン)ポリマー母材中のドーパントとして本発明の赤色発光材料を使用するOLEDの形成について説明する。得られたブレンドは、OLED中の活性赤色発光層として用いられる。イリジウム錯体、[Ir (acac) {1-(4-t-Bu-フェニル)-イソキノリン}2]、表1の1-j化合物を、実施例6に記載したように調製する。ポリフルオレンポリマーは、(非特許文献4)に記載されているように調製する、そこにおいて、モノマー単位のジハロ、好ましくはジブロモ誘導体が、ビス(1, たさせられる。

[0077]

このOLEDの実施例の有機フィルム成分はすべて、溶液処理される。デバイス集成体は、以下の通りである。1TO/ガラス基材(アプライドフィルム(Applied Films))をパターン化し(デバイス作用面積=全3cm²)、実施例10に記載したように洗浄した。次いで、基材を更に洗浄するために、15分間、300Wのプラズマ炉内

[0078]

デバイスを十分に特性決定するために、電流-電圧、輝度-電圧、輝度-電流、効率-電圧、及び効率-電圧のプロフィルを獲得する。これは、コンピュータ駆動(ラブビュー(Labview)ソフトウェア)ケイスレイソース-測定装置及びフォトダイオードを用いて実施され、後者は、全3cm²のデバイス作用面積にわたって光出力を積分した。

【図面の簡単な説明】

[0079]

- 【図1】本発明の金属錯体中で有用な配位子Lの式III~VIIを示す。
- 【図2】本発明の金属錯体中で有用で配位子Lの式VIII~Xを示す。
- 【図3】本発明において有用なβ-エノラート配位子の式XI及びホスフィノアルコキシド配位子の式XIIを示す。
- 【図4】 本発明において有用な親配位子化合物HLの合成の反応式 (1) を示す。
- 【図5】 本発明において有用な錯体を形成するための反応式 (2) ~ (4) を示す。
- 【図6】発光デバイス (LED) の略図である。
- 【図7】LED試験装置の略図である。

10

[図1]



$$\{x_1,y_2,\dots,(x_1)\}$$

$$\{x_1,y_2,\dots,(x_1)\}$$

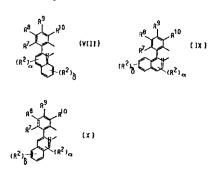
$$\{x_1,y_2,\dots,(x_1)\}$$

$$\{x_1,y_2,\dots,(x_1)\}$$

$$\{x_1,y_2,\dots,(x_1)\}$$

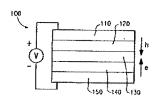
$$\{x_1,y_2,\dots,(x_1)\}$$

【図2】



[図5]

【図6】

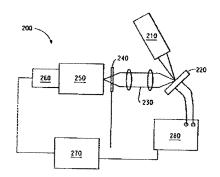


[図3]

【図4】

$$0 = 8(0H)_2 * trit Hyder$$

【図7】



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公表番号】特表 2005-508437(P2005-508437A)

【公表日】平成17年3月31日(2005.3.31)

【年通号数】公開·登録公報2005-013

【出願番号】特願2003-542296(P2003-542296)

【国際特許分類】

C 0	9 K	11/06	(2006.01)
C 0	7 D	215/10	(2006.01)
C 0	7 D	217/10	(2006.01)
c o	7 D	217/16	(2006.01)
C 0	7 D	401/04	(2006.01)
C 0	7 D	409/04	(2006.01)
C 0	7 F	15/00	(2006.01)
H 0	1 L	51/50	(2006, 01)

[FI]

С	0	9	K	11/06	6	6	0
C	0	7	D	215/10			
С	0	7	D	217/10			
C	0	7	D	217/16			
С	0	7	D	401/04			

C 0 7 D 409/04

C 0 7 D 409/04 C 0 7 F 15/00 E H 0 5 B 33/14 B C 0 7 M 5:00

【手続補正書】

【提出日】平成17年10月24日(2005.10.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

式 I 及び式 I I:

から選択される式を有する少なくとも1つの化合物を含む活性層であって、 式中、

Zが、β-ジエノレート、アミノカルボキシレート、イミノカルボキシレート、サリチレート、ヒドロキシキノレート、及びジアリールホスフィノアルコキシドから選択され、

Lが、図1の式I I I I 、式I V 、式V I 、及び式V I I 、ならびに図2 の式V I I 、式I X D V 式X から選択され、

式IIIにおいて、

 $R^3 \sim R^6$ が同一または異なっており、 $R^3 \sim R^6$ の少なくとも1つが、D、F、C $_n$ F $_2$ $_{n+1}$ 、O C $_n$ F $_2$ $_{n+1}$ 、及びO C F $_2$ Y から選択され、式111~VIIのいずれかにおいて、出現するごとに、

 R^1 が、出現するごとに、同一または異なっており、D、 C_n H_{2n+1} 、 OR^{1-1} 、 SR^{1-1} 、N $(R^{1-1})_2$ 、F、 C_n $(H+F)_{2n+1}$ 、 OC_n $(H+F)_{2n+1}$ 、及び OCF_2 Y から選択されるか、または隣接する一対の R^1 が結合して 5 または 6 員環を形成することができ、

YがH、C1、またはBrであり、

AがSまたはNR¹¹であり、

式III~Xのいずれかにおいて、出現するごとに、

 R^{-1} が、出現するごとに、同一または異なっており、Hまたは C_n H_{2-n+1} であり

nが1~12の整数であり、

αが0、1または2であり、

式IV~Xのいずれかにおいて、出現するごとに、

δが0または1~4の整数であり、

式VIIにおいて、

 $E^{-1}\sim E^{-4}$ が同一または異なっており、Nまたは $CR^{-1/2}$ であるが、ただし、少なくとも1つのEがNであり、

式VIII~Xのいずれかにおいて、出現するごとに、

 R^2 及び R^7 ~ R^{10} が、出現するごとに、同一または異なっており、H、D、C,H 2n+1、〇 R^{11} 、S R^{11} 、及び N (R^{11}) $_2$ から選択され、または隣接した一対の R 基が結合して 5 または 6 員環を形成することができるが、

ただし、活性層が、前記少なくとも1つの化合物、20重量%未満を含有する場合、希釈剤が存在していることを特徴とする活性層。

【請求項2】

570~700nmの範囲の発光最大を有する発光材料を含むことを特徴とする、請求項1に記載の活性層を含む有機電子デバイス。

【請求項3】

表1に示した錯体1-a~1-mから選択される化合物。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0078

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0078]

デバイスを十分に特性決定するために、電流一電圧、輝度一電圧、輝度一電流、効率一電圧、及び効率一電圧のプロフィルを獲得する。これは、コンピュータ駆動(ラブビュー(Labview)ソフトウェア)ケイスレイソースー測定装置及びフォトダイオードを用いて実施され、後者は、全3cm²のデバイス作用面積にわたって光出力を積分した。本発明は以下の実施の態様を含むものである。

1. 式 I 及 び 式 I I:

 $\begin{array}{ccc}
 & \text{Ir L}_3 & \text{(I)} \\
 & \text{Ir L}_2 Z & \text{(II)}
\end{array}$

から選択される式を有する少なくとも1つの化合物を含む活性層であって、 式中、

Zが、β-ジェノレート、アミノカルボキシレート、イミノカルボキシレート、サリチレート、ヒドロキシキノレート、及びジアリールホスフィノアルコキシドから選択され、

Lが、図1の式III、式IV、式V、式VI、及び式VII、ならびに図2の式VII、式IX及び式Xから選択され、

式IIIにおいて、

 $R^3 \sim R^6$ が同一または異なっており、 $R^3 \sim R^6$ の少なくとも1つが、D、F、C n F 2 n + 1 、OC n F 2 n + 1 、及びOC F 2 Y から選択され、

式III~VIIのいずれかにおいて、出現するごとに、

 R^{-1} が、出現するごとに、同一または異なっており、D、 C_n H_{2n+1} 、 OR^{-1} 1、S R^{-1} 、N $(R^{-1}$) $_2$ 、 $_5$ 、 C_n (H+F) $_{2n+1}$ 、 OC_n (H+F) $_{2n+1}$ 、D $UOCF_2$ Y から選択されるか、または隣接する一対の R^{-1} が結合して5または6 負環を形成することができ、

YがH、C1、またはBrであり、

AがSまたはNR¹¹であり、

式III~Xのいずれかにおいて、出現するごとに、

 R^{1-1} が、出現するごとに、同一または異なっており、Hまたは C_n H_{2-n+1} であり、

nが1~12の整数であり、

<u>αが0、1または2であり、</u>

式IV~Xのいずれかにおいて、出現するごとに、

δが0または1~4の整数であり、

式VIIにおいて、

 $E^{-1} \sim E^{-4}$ が同一または異なっており、Nまたは $CR^{-1/2}$ であるが、ただし、少なくとも 1 つのEがNであり、

 R^{1-2} が、出現するごとに、同一または異なっており、H、D、 SR^{1-1} 、N (R^{1-1}) $_2$ 、 $_F$ 、C 。 (H+F) $_2$ $_{n+1}$ 、OC 。 (H+F) $_2$ $_{n+1}$ OC 。 (H+F) OC 。 (H+F)

式VIII~Xのいずれかにおいて、出現するごとに、

 R^2 及び R^7 ~ R^{1-0} が、出現するごとに、同一または異なっており、H、D、C。H 2 n + 1 、 O R^{1-1} 、 S R^{1-1} 、 D R^{1-1} 、 D

ただし、活性層が、前記少なくとも1つの化合物、20重量%未満を含有する場合、希釈 剤が存在していることを特徴とする活性層。

2.570~700nmの範囲の発光最大を有する発光材料を含むことを特徴とする、前記1に記載の活性層を含む有機電子デバイス。

3. R^{5} が CF_{3} であり、及び/または R^{8} が OCH_{3} 及び OH から選択され、及び/または R^{9} が t - ブチルであることを特徴とする、前記 1 に記載の活性層、または前記 2 に記載のデバイス。

 $4.\ N,\ N'-ジフェニル-N,\ N'-ビス(3-メチルフェニル)-[1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジアミン、1,1-ビス [(ジ-4-トリルアミノ)フェニル]シクロヘキサン、<math>N,\ N'-ビス(4-メチルフェニル)-N,\ N'-ビス(4-エチルフェニル)-[1,1'-(3,3'-ジメチル)ビフェニル]-4,4'-ジアミン、テトラキス-(3-メチルフェニル)-N,N,N',N'-2,5-フェニレンジアミン、<math>\alpha$ -フェニル-4-N,N-ジフェニルアミノスチレン、p-(ジエチルアミノ)ベンズアルデヒドジフェニルヒドラゾン、トリフェニルアミン、ビス [4-(N,N-ジェチルアミノ)-2-メチルフェニル](4-メチルフェニル)メタン、1-フェニル-3-[p-(ジエチルアミノ)スチリル]-5-[p-(ジエチルアミノ)フェニル]ピラゾリン、1,2-トランスービス(9-Hーカルバゾル-9-イル)シクロブタン、1-バージアミン、1-グアミン、ポルフィリン化合物、及びそれらの組合せから選択される正孔輸送層を更に

含むことを特徴とする、前記2または3に記載のデバイス。

5. トリス(8-ヒドロキシキノラト)アルミニウム、2, 9-ジメチルー4, 7-ジフェニルー1, 10-フェナントロリン、4, 7-ジフェニルー1, 10-フェナントロリン、2-(4-ビフェニリル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール、3-(4-ビフェニリル)-4-フェニルー5-(4-t-ブチルフェニル)-1, 2, 4-トリアゾール、及びそれらの組合せから選択される電子輸送層を更に含むことを特徴とする、前記 2 \sim 4 のいずれかに記載のデバイス。

- 6. 表1に示した錯体1-a~1-mから選択される化合物。
- 7. 式I及び式IIから選択される式を有する前記少なくとも1つの化合物が、表1に示した錯体1-a~1-mから選択されることを特徴とする、前記1または3に記載の活性層、あるいは前記2~5のいずれかに記載のデバイス。
- 8. 前記希釈剤が、ポリ(Nービニルカルバソール)、ポリシラン、4,4'-N,N'-ジカルバソールビフェニル、及び第三級芳香族アミンから選択されることを特徴とする、前記1、3及び7のいずれかに記載の活性層、あるいは前記2~5、及び7のいずれかに記載のデバイス。
- 9. 前記希釈剤が、ポリアリーレンビニレン、ポリフルオレン、ポリオキサジアゾール、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピリジン、ポリフェニレン、それらのコポリマー、及びそれらの組合せから選択される共役ポリマーであることを特徴とする、前記1、3及び7~8のいずれかに記載の活性層、あるいは前記2~5、及び7~8のいずれかに記載の有機電子デバイス。
- 10. 前記希釈剤が、ポリアリーレンビニレン、ポリフルオレン、ポリオキサジアゾール、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピリジン、ポリフェニレン、それらのコポリマー、及びそれらの組合せから選択される共役ポリマーであることを特徴とする、前記1、3及び7~9のいずれかに記載の活性層、あるいは前記2~5及び7~9のいずれか一項に記載の有機電子デバイス。